```
Family list
```

6 application(s) for JP11204529

Pattern formation method and substrate manufacturing

apparatus

Inventor: KIGUCHI HIROSHI [JP]; FUKUSHIMA Applicant: SEIKO EPSON CORP [JP]

HITOSHI (JPI (+2) IPC: B41J2/01; H01L21/00; H01L21/3205; (+12) EC: H05K3/12C; H01L21/00S2V; (+4)

Publication info: EP0930641 (A2) - 1999-07-21 EP0930641 (A3) - 2000-02-02 EP0930641 (B1) - 2008-12-03

METHOD OF FORMING PATTERN AND DEVICE FOR

MANUFACTURING SUBSTRATE

Applicant: SEIKO EPSON CORP Inventor: KIGUCHI HIROSHI : SHIMODA

TATSUYA (+2)

IPC: B41J2/01; H01L21/00; H01L21/3205; (+13) EC: H05K3/12C; H01L21/00S2V; (+4)

Publication info: JP11204529 (A) - 1999-07-30 JP4003273 (B2) -- 2007-11-07

Pattern forming method and manufacturing device for

substrate

Inventor: KIGUCHI HIROSHI [JP] ; FUKUSHIMA Applicant: SEIKO EPSON CORP [JP] HITOSHI [JP] (+2) IPC: B41J2/01; H01L21/00; H01L21/3205; (+12)

EC: H05K3/12C: H01L21/00S2V; (+4) Publication Info: TW383280 (B) - 2000-03-01

PATTERN FORMATION METHOD AND SUBSTRATE

MANUFACTURING APPARATUS Inventor: KIGUCHI HIROSHI [JP] ; FUKUSHIMA Applicant: KIGUCHI HIROSHI, ; FUKUSHIMA HITOSHI, (+3) HITOSHI [JP] (+2) IPC: B41J2/01; H01L21/00; H01L21/3205; (+12)

EC: H05K3/12C: H01L21/00S2V: (+4)

Publication info: US2003003231 (A1) -- 2003-01-02 US6599582 (B2) - 2003-07-29

Pattern formation method and substrate manufacturing apparatus

HITOSHI [JP] (+2) EC: H05K3/12C; H01L21/00S2V; (+2)

Inventor: KIGUCHI HIROSHI [JP] ; FUKUSHIMA Applicant: KIGUCHI HIROSHI, ; FUKUSHIMA HITOSHI, (+3) IPC: H01L21/00; H01L21/768; H01L51/00; (+8)

Publication Info: US2004048001 (A1) - 2004-03-11 US6877853 (B2) - 2005-04-12

Pattern formation method and substrate manufacturing

apparatus HITOSHI [JP] (+2)

Inventor: KIGUCHI HIROSHI [JP] ; FUKUSHIMA Applicant: KIGUCHI HIROSHI, ; FUKUSHIMA HITOSHI. (+3) IPC: H01L21/00; H01L21/768; H01L51/00; (+8)

EC: H05K3/12C; H01L21/00S2V; (+2) Publication info: US2005146588 (A1) - 2005-07-07 US7114802 (B2) - 2006-10-03

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

METHOD OF FORMING PATTERN AND DEVICE FOR MANUFACTURING SUBSTRATE

Patent number: JP11204529 (A)
Publication date: 1999-07-30

Applicant(s):

Publication date: 1999-07-30
Inventor(s): KIGUCHI HIROSHI; SHIMODA TATSUYA; FUKUSHIMA

HITOSHI, NEHASHI SATOSHI SEIKO EPSON CORP

Classification:

- international: B41J2/01; H01L21/00; H01L21/3205; H01L21/768; H01L51/00: H01L51/40: H05K3/12; B41J2/01; H01L21/00;

H01L51/00; H01L51/40; H05K3/12; B4132/01; H01L21/03; H01L21/02; H01L21/70; H01L51/00; H01L51/05; H05K3/12;

(IPC1-7): H01L21/3205; B41J2/01

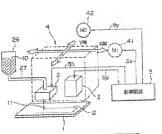
- european: H05K3/12C; H01L21/00S2V; H01L21/288; H01L21/768;

H01L21/768C; H01L51/00A2B2B

Application number: JP19980008016 19980119 Priority number(s): JP19980008016 19980119

Abstract of JP 11204529 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacturing technology for a substrate for forming a pattern on a substrate by the use of an ink jet system. SOLUTION: A substrate manufacturing device is provided for forming an arbitrary pattern on a substrate 1 by a fluidized body 11. This device is provided with an ink jet type recording head 2, which is constituted so that the fluidized body 11 can be projected on a substrate 1, processing means 3 for operating a constant processing on the substrate 1, drive means 4 for changing the relative position of the ink jet type recording head 2 and the processing means 3 to the substrate 1, and control means 5 for controlling the projection of the fluidized body 11 from the ink jet type recording head 2, the processing by the processing means 3, and the driving by the driving means 4., The control means is constituted capable of controlling the processing means to executing the processing, prior to the projection of the fluidized body from the ink jet type recording head 2.



KIO、禁犯額限額数

Also published as:

JP4003273 (B2)

FP0930641 (A2)

FP0930641 (A3)

EP0930641 (B1)

more >>

US2003003231 (A1)

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-204529

(43) 公開日 平成11年(1999) 7月30日

(51) Int.Cl. ⁶	織別記号	FΙ	
H 0 1 L 21/3205		HO1L 21/88	В
B 4 1 I 2/01		B41J 3/04	101Z

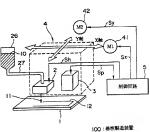
		審查請求	未請求 請求項の数38 OL (全 16 頁)
(21)出願番号	特顯平10-8016	(71)出額人	セイコーエプソン株式会社
(22) 計算日	平成10年(1998) 1月19日		東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
		(72)発明者	木口 浩史 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ ーエブソン株式会社内
		(72)発明者	下田 達也 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ ーエプソン株式会社内
		(72)発明者	福島 均 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ ーエプソン株式会社内
		(74)代理人	弁理士 鈴木 喜三郎 (外2名) 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 パターン形成方法および基板製造装置

(57) 【要約】

5.

【課題】 インクジェット方式を使用して基板にパター ン形成を可能とする基板の製造技術を提供する。 【解決手段】 流動体11により基板1上に任意のパター ンを形成するための基板製造装置に関する。当該装置 は、流動体11を基板1上に吐出可能に構成されたインク ジェット式記録ヘッド2、基板1上に一定の処理を行う 処理手段3、インクジェット式記録ヘッド2および処理手 段3と基板1との相対位置を変更可能に構成される駆動手 段4、およびインクジェット式記録ヘッド2からの流動体 11の吐出、処理手段3による処理並びに駆動手段4による 駆動を制御する制御手段5を備える。制御手段5は、処理 手段による処理をインクジェット式記録ヘッド2からの 流動体の吐出に先行して行わせることが可能に構成され



【特許請求の範囲】

【請求項1】 インクジェット式記録ヘッドより所定の 流動体を基板上に吐出して任意のパターンを形成するパ ターン形成方法であって、

前記流動体の吐出前に予め前記基板上に一定の処理を行 うステップと、

前記処理をした基板上に前記インクジェット式記録へッ ドより前記流動体を吐出するステップと、を備えたこと を特徴とするパターン形成方法。

【請求項2】 インクジェット式記録ヘッドより所定の 流動体を基板上に吐出して任意のパターンを形成するパ ターン形成方法であって、

前記インクジェット式記録ヘッドより所定の流動体を基 板上に吐出するステップと、

前記流動体が吐出された前記基板に一定の処理を行うステップと、を備えたことを特徴とするパターン形成方

【請求項3】 インクジェット式記録ヘッドより所定の 流動体を基板上に吐出して任意のパターンを形成するパ ターン形成方法であって、

前記インクジェット式記録ヘッドより所定の流動体を吐 出するステップと、

前記インクジェット式記録ヘッドより吐出された流動体 が前記基板に到達する前までに、当該吐出された流動体 の液滴に一定の処理を行うステップと、を備えたことを 特徴とするパターン形成方法。

【請求項4】 前記処理は、前記流動体に化学的作用を 及ぼす処理である請求項1乃至請求項3のいずれか一項 に記載のパターン形成方法。

【請求項5】 前記処理は、前記流動体に含まれる所定 物質の溶解度を低下させ、当該物質を折出させる処理で ある請求項1または請求項2に記載のパターン形成方 3十分

【請求項6】 前記処理は、前記流動体に化学反応を生 じさせる物質を前記基板に吐出する処理である請求項1 または請求項2に記載のパターン形成方法。

【請求項7】 前配処理は、前配流動体に物理的作用を 及ぼす処理である請求項1乃至請求項3のいずれか一項 に記載のパターン形成方法。

【請求項8】 前記処理は、前記パターン形成領域の境 界に沿って吐出された前記流動体の境界を整形する処理 である請求項2に記載のパターン形成方法。

【請求項9】 前記処理は、前記パターン形成領域に沿って吸収体を移動させることにより、過剰な前記流動休 を前記吸収体に吸収させる処理である請求項2に記載の パターン形成方法。

【請求項10】 前記処理は、前記流動体に物理化学的 作用を及ぼす処理である請求項1万至請求項3のいずれ か一項に記載のパターン形成方法。

【請求項11】 前記処理は、前記基板のうち前記パタ

ーン形成領域の周囲を前記流動体に対し非親和性に表面 改質する処理である請求項1に記載のパターン形成方 法。

【請求項12】 前記処理は、前記基板のうち前記パタ ーン形成領域を前記流動体に対し親和性に表面改質する 処理である請求項1に記載のパターン形成方法。

【請求項13】 前記処理は、前記基板のうち前記パタ 一ン形成領域を、前記流動体を吸収する吸収層に表面改 質する処理である請求項1に記載のパターン形成方法。

【請求項14】 前記処理は、前記パターン形成領域の 周囲に前記流動体が流出することを防止するためのバン クを形成する処理であって、

前記パターンの形成後当該パンクを除去する工程をさら に備える請求項2に記載のパターン形成方法。

【請求項15】 前記処理は、既に前記流動体が吐出されている前記パターン領域に沿ってさらに同一の流動体を吐出する処理である請求項2に記載のパターン形成方法。

【請求項16】 前記処理は、前記液滴にエネルギーを 供給し、当該流動体の濃度を上昇させる処理である請求 項3に記載のパターン形成方法。

【請求項17】 前記処理は、前記液滴にエネルギーを 供給し、当該液滴の軌道を曲げる処理である請求項3に 記載のパターン形成方法。

【請求項18】 前記処理は、前記流動体に化学反応を 生じさせる物質を、前記液滴に作用させる処理である請 求項3に記載のパターン形成方法。

【請求項19】 前記処理は、前記液滴の属性を検出する処理であって、

検出された前紀被演の展性に基づいて、前記インクジェット式記録ヘッドからの前記液滴の吐出を削御するステップをさらに備える請求項3に記載のパターン形成方法。

【請求項20】 所定の流動体により基板上に任意のパターンを形成するための基板製造装置であって、

前記流動体を前記基板上に吐出可能に構成されたインク ジェット式記録ヘッドと、

前記基板上に一定の処理を行う処理手段と、

前記インクジェット式記録ヘッドおよび前記処理手段と 前記基板との相対位置を変更可能に構成される駅動手段

前記インクジェット式記録ヘッドからの前記流動体の吐出、前記処理手段による前記処理並びに前記駆動手段による駆動を制御する制御手段と、を備え、

前記制御手段は、前記処理手段による処理を前記インク ジェット式記録ヘッドからの流動体の吐出に先行して行 わせることが可能に構成された基板製造装簾。

【請求項21】 所定の流動体により基板上に任意のバ ターンを形成するための基板製造装置であって、 前記流動体を前記基板上に吐出可能に構成されたインク ジェット式記録ヘッドと、

前記基板上に一定の処理を行う処理手段と、

前記インクジェット式記録ヘッドおよび前記処理手段と 前記基板との相対位置を変更可能に構成される駆動手段

前記インクジェット式記録ヘッドからの前記流動体の吐出、前記処理手段による前記処理並びに前記駆動手段による駆動を制御する制御手段と、を備え、

前記制御手段は、前記インクジェット式記録ヘッドから の流動体の吐出を処理手段による処理に先行して行わせ ることが可能に構成された基板製造装置。

【請求項22】 所定の流動体により基板上に任意のパ ターンを形成するための基板製造装置であって、

前記流動体を前記基板上に吐出可能に構成されたインク ジェット式記録ヘッドと、

前記インクジェット式記録ヘッドから吐出された流動体 の液滴が基板に到達する前に当該液滴に一定の処理を行 う処理手段と、

前記インクジェット式記録ヘッドおよび前記処理手段と 前記基板との相対位置を変更可能に構成される駆動手段 と、

前記インクジェット式記録〜ッドからの前記流動体の吐出、前記処理手段による前記処理並びに前記処理動手段による那記処理並びに前記駆動手段による駆動を削削する制御手段と、を備えたことを特徴とする基核制造装置。

【請求項23】 前記処理手段は、前記流動体に化学的 作用を及ぼすことが可能に構成される請求項20万至請 求項22のいずれか一項に記載の基板製造装置。

【請求項24】 前記処理手段は、前記流動体に含まれる所定物質の溶解度を低下させ、当該物質を折出させる ことが可能に構成される請求項20または請求項21に 新数の基係製造装置。

【請求項25】 前記処理手段は、前記流動体に化学反 応を生じさせる物質を前記基板に吐出することが可能に 構成される請求項20または請求項21に記載の基板製 造装置。

【請求項26】 前記処理手段は、前記流動体に物理的 作用を及ぼすことが可能に構成される請求項20万至請 求項22のいずれか一項に記載の基板製造装置。

【請求項27】 前記処理手段は、前記パターン形成領 域の境界に沿って吐出された前記流動体の境界を整形可 能に構成される請求項21に記載の基板製造装置。

【請求項28】 前記処理手段は吸収体を備え、前記制 翻手段は前記パターン形成領域に沿って前記規則体 対的に移動させることにより、過剰な前記域制を前記 吸収体に吸収させる請求項21に記載の基板製造装置。

【請求項29】 前記処理手段は、前記流動体に物理化 学的作用を及ぼすことが可能に構成される請求項20万 至請求項22のいずれか一項に記載の基板製造装置。

【請求項30】 前記処理手段は、前記基板のうち前記

パターン形成領域の周囲を前記流動体に対し非親和性に 表面改質することが可能に構成される請求項20に記載 の系板製造装置。

【請求項31】 前記処理手段は、前記基板のうち前記 バターン形成領域を前記流動体に対し規和性に表面改質 することが可能に構成される請求項20に記載の基板製 言基層。

【請求項32】 前記処理手段は、前記基板のうち前記 バターン形成領域を、前記活動体を吸収する吸収層に表 面改質することが可能に構成される請求20に記載のバ ターン形成方法。

【請求項33】 前記処理手段は、前記パターン形成領 域の周囲に前記流動体が流出することを防止するための バンクを形成可能に構成され、

当該製造装置は、前記パターンの形成後当該パンクを除 去する手段をさらに備える請求項22に記載の基板製造 装置。

【請求項34】 所定の流動体により基板上に任意のパ ターンを形成するための基板製造装置であって、 前記滤動体を前記基板上に吐出可能に構成されたインク

ジェット式記録ヘッドと、 前記インクジェット式記録ヘッドと前記基板上との相対

前記インクジェット式記録ヘッドと前記基板上との相欠 位置を変更可能に構成される駆動手段と、

前記インクジェット式記録へッドからの前記流動体の吐 出および前記駆動手段による駆動を制御する制御手段 と、を備え、

前記制御手段は、既に前記流動体が吐出されている前記 パターン領域に沿って前記インクジェット式記録ヘッド からさらに同一の流動体を吐出する基板製造装置。

【請求項35】 前記処理手段は、前記被滴にエネルギーを供給し、当該流動体の濃度を上昇させることが可能 に構成される請求項22に記載の基板製造装置。

【請求項36】 前記処理手段は、前記液滴にエネルギーを供給し、当該液滴の軌道を曲げることが可能に構成される請求項22に記載の基板製造装置。

【請求項37】 前記処理手段は、前記流動体に化学反応を生じさせる物質を、前記液滴に供給可能に構成される請求項22に記載の基板製造装置。

【請求項38】 前記処理手段は、前記液滴の属性を検 出する可能に構成され、

前記制御手段は、前記処理手段により検出された前記被 満の属性に基づいて、前記インクジェット式記録ヘッド からの前記被演の吐出および前記報声号による駆動を 制御する請求項22に記載の基板製造装覆。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明はインクジェット式記 録へッドの工業的応用に係り、特にインクジェット方式 によって任意のバターンを形成するための製造技術に関 する。

[0002]

【従来の技術】半導体プロセス等で用いる基板はシリコ ン等で構成されている。従来、当該シリコン基板から集 積回路等を製造するために、リソグラフィー法等が使用 されていた。

【0003】このリソグラフィー法は、シリコンウェハ 上にレジストと呼ばれる態気材を薄く薬布し、ガラス乾 板に写真製版で作成した集相回路パターンを光で焼き付 けて転写する点である。転写されたレジストパターンに イオン等を打ち込んで、配線パターンや素子を形成して いくものできった。

【0004】上記リソグラフィー法を用いるには、写真 製版、レジスト始布、霧光、現像等の工程を必要として いたため、設備の整った半準体工場等でなければ微細パ クーンの作成ができなかった。このため微細パターンの 形成は、複雑な工程管理とコストを要するのが常識であった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが、超LSIほどの散揚パターンまではいかなくても、µmのオーダーのパターンを簡単に、しかも安価にかつ工場等の設備を用いることなく、製造することができるものとすれば、工業的に無限の需要が考えられる。

【00061】ところで、出版人は用紙に印字する技術と してインクジェット方式に技術的素質がある。インクジ ェット方式ではインクを出出させるためにインクジェット 大武配縁へッドを使用する、このヘッドはインクを月 紙上に出することによって印字を行うものであった。 いままでインクジェット方式の応用はまとして印字を目 的とするプリングに用いられてきた。

【0007】インクジェット式記録ヘッドは結性が低い 流動体であれば任意の流動林を吐出可能である。しかも このインクジェット式記録ヘッドの解像度は、例えば4 00bplと微細である。このためインクジェット式記 録ヘッドの個々のノズル穴から工業的用途に使える流動 体を吐出できれば、μ加オーゲーの幅で任意のバターン が形成できると考えられる。インクジェット方式によれ は、工場のような設備を必要としない。

【0008】しかし流動体によるパターン形成には流動体をパターンとして定着させるための関連処理が必要になるため、インクジェット式記録ペッドから流動体を出口領に構成するのみではパターンを形成することができない。例えば、基板にパターンを定着させるためには、流動体から工業材料を出現させるための化学的処

は、流動体から工業材料を出現させるための化デキが 理、パターンの形を整えるための物理的処理、あるいは パターン形成領域にパターン材料を正しく定蓄させるた めの物理化学的処理が必要になる。

【0009】ただし流動体に対して処理をするとはいって、大がかりな製造装置を使用するのでは、手軽にバタ

一ンを形成することを目的としたインクジェット方式に FA基板製造の利点が生かせない。

[0010]

【課題を解決するための手段】そこで、本願発明者はイ ンクジェット方式によってパターン形成を行うにあた り、インクジェット式記録へッドの前後またはヘッドか ら吐出された瞬間に、パターン形成に必要な処理を完遂 させる技術を考案した。

【0011】 すなわち本発明の第1の課題は、基板上に 流動体が吐出される前に処理可能とすることによりバタ ーンを形成可能とする方法およびその製造装置を提供す ることである。

【0012】本発明の第2の課題は、基板上に流動体が 吐出された後に処理可能とすることによりパターンを形 成可能とする方法およびその製造装置を提供することで ある。

【0013】本発明の第3の課題は、流動体が出出された時間に処理可能とすることによりパターンを形成可能とする方法およびその製造機を指供することである。 【0014】上記第1の課題を解決する発明は、インクジェット式起機へッドより所定の流動体を基板上に吐出して任意のパターンを形成するパターン形成方法であって、前記機動体の出始能に予め前記基板上に一定の処理を行うステップと、前記処理をした基板上に前記インクジェットを確念と

【0015】ここで、流動体とはインクのみならず工業度の用途に用いることができ、ノズルから吐出可能な粘度を備えた媒体をいう。水性であると油性であるとを問わない。ノズル等から吐出可能な流動性(括度)を備えていれば十分で、個体物質が混入していても全体として流動体であればよい。インクジェット式記録へフドス、電体素子の仕様変化により流動体を吐出させる方式であっても、熱の印加により急激に蒸気が発生することにより流動体を出出させる方式であっても、状で学的処理でも、物理化学的処理でも、物理化学的処理でも、物理化学的処理でも、物理化学的処理でもよい、二九ち定義は以下同様に用いる。

【0016】上部第2の課題を解決する差明は、インタジェット式記録ヘッドより所定の流動体を基板上に吐出して任意の小やシンを形成するパターン形成力器であって、インクジェット式記録ヘッドより所定の流動体を基板上に生出するステップと、流動体が吐出された基板に一定の処理を行うステップと、を備える。

【0017】上記第3の課題を解決する差別は、インクジェット式記録ヘッドより所定の流動体を基板上に吐出して任意の小をデットンを形成するパターン形成方法であって、インクジェット式記録ヘッドより所定の流動体を吐出するステップと、インクジェット式記録ヘッドより所定の流動体を吐出される元動を小で、「該吐出された流動体の企商に一定の処理を行うステップと、を備れた流動体の企商に一定の処理を行うステップと、を備れている。

える。

[0018] 例えば上記処理は、流動体に化学的作用を 及ぼす処理である。化学的作用とは、物質に析出や化学 反広等をいう例えばこの処理は、流動体に含まれる所 定物質の溶解度を低下させ、当該物質を折出させる処理 である。この処理は、例えば熱風吹き付け、レーザ照 が、ランブ解は、滅圧、変罪を発化(推度さえびぎス

ト)を振設または流動体に与えることにより得られるものである。またこの処理は、流動体に化学反応を生じさせる物質を基板に吐出する処理である。またこの処理は、液滴にエネルギーを供給し、当該流動体の適度を上昇させる処理である。さらにこの処理は、液滴にエネルギーを供給し、当該液菌の軌道を曲げる処理である。

【0019】例えば上記処理は、流動体に参乗的作用を 及ぼす処理である。物理的作用とは、流動体に力学的、 電気学的、磁気学的な影響を及ぼすことをいう。この処 理は、例えば、パターン形成領域の境界に沿って吐出さ れた流動体の業界を整形する処理である。またこの処理 は、パターン形成領域に沿って吸収体を移動させること により、温剰な流動体を吸収体に吸収させる処理であ る。

【0020】例えば上記処理は、流動体に物理化学的作 用を及ぼす処理である。物理化学的処理とは、物理的作 用と化学的作用の相互から流動体の挙動に影響を与える ことをいう。この処理は、例えば基板のうちパターン形 成領域の周囲を流動体に対し非親和性に表面改質する処 理である。またこの処理は、基板のうちパターン形成領 域を流動体に対し親和性に表面改質する処理である。こ こで非親和性とは、流動体に対する相対的に接触角が大 きい性質をいう。親和性とは、流動体に対する接触角が 相対的に小さいことをいう。これらの表現は、流動体に 対する膜の挙動を明らかにするために、親和性と対比し て用いられるものである。この処理は、基板のうちパタ ーン形成領域を、流動体を吸収する吸収層に表面改質す る処理である。さらにこの処理は、バターン形成領域の 周囲に流動体が流出することを防止するためのバンクを 形成する処理であり、パターンの形成後当該バンクを除 去する工程をさらに備える。さらにまたこの処理は、既 に流動体が吐出されているパターン領域に沿ってさらに 同一の流動体を吐出する処理である。さらにまたこの処 理は、流動体に化学反応を生じさせる物質を、液滴に作 用させる処理である。また、この処理は、液滴の属性を 検出する処理であって、検出された液滴の属性に基づい て、インクジェット式記録ヘッドからの液滴の吐出を制 御するステップをさらに備える。

 との相対位置を変更可能に構成される駆動手段と、イン クジェット式記録へッドからの流動体の出出、 処理手段 による処理および駆動手段による駆動を削御する制御手 段と、を備える。そして制御手段は、处理手段による処理 理をインクジェット式記録〜ッドからの流動体の吐出に 先行して行わせることが可能と構成される。

【0022】また本美明は、所定の流動体により基板上に任意のパターンを形成するための基板製造装置であって、流動体を基板上に仕事の開発に構成されたインクジェット式配線へッドがよび処理手段と基板との相対位置を変更可能に構成される駆動手段とよくシクジェット式配線へッドからの流動体の吐出、処理手段による処理および駆動手段による駆動を削削する制即手段と、を備える。そして制御手段は、インクジェット式配線へッドからの流動体の吐出を処理手段による処理による処理なよび駆動手段による処理をよる駆動を削削する制御手段による処理などなが変動手段による駆動を制御するよる処理をしたが可能に構成される。

【0023】本発明は、所定の流動がにより基板上に任意のパターンを形成するための基板製造装置であった大 流動体を基板上に比出可能に構成されたインタジェット 式記録へッドと、インタジェット式記録へッドから吐出 された意動体の液滴が基板に到達する前に当該液滴に 定の処理を行う処理手段と、インクジェット記録へ ドおよび処理手段と、基板との相対位置を変更可能に構成 される駆動手段と、インクジェット式記録へッドからの 流動体の世出、処理手段による処理および駆動手段によ る駆動を制即する側針手段と、を傾える。

【0024】例えば上記処理手段は、流動体に化学的作 用を及ぼすことが可能に構成される。

【0025】また処理手段は、流動体に含まれる所定物 質の溶解度を低下させ、当該物質を析出させることが可 能に構成される。

【0026】さらに処理手段は、流動体に化学反応を生じさせる物質を基板に吐出することが可能に構成され

【0027】さらにまた処理手段は、流動体に物理的作 用を及ぼすことが可能に構成される。

【0028】また理手段は、パターン形成領域の境界に 沿って吐出された流動体の境界を整形可能に構成され ス

【0029】さらに処理手段は坂収体を備え、制御手段 はパターン形成領域に沿って吸収体を相対的に移動させ ることにより、過剰が流動体を吸収体に吸収させる。 【0030】さらにまた処理手段は、流動体に物理化学

的作用を及ぼすことが可能に構成される。 【0031】また処理手段は、基板のうちパターン形成 領域の周囲を流動やに対し非親和性に表面改質すること が可能に様めされる、非親和性とは、流動体に対する相

領域の周囲を流動体に対し手線和性に表面には、3つこと が可能に構成される。非親和性とは、流動体に対する相 対的に接触角が大きい性質をいう。この表現は、流動体 に対する機の挙動を明らかにするために、親和性と対比 して用いられるものである。

[0032] さらに処理手段は、基板のうちパターン形 放策域を流動体に対し親和性に表面放質することが可能 に精成される。ここで、親和性とは、流動体に対する接 触角が相対的に小さいことをいう。

【0033】さらに処理手段は、基板のうちパターン形成領域を、流動体を吸収する吸収層に表面改質することが可能に構成される。

【〇〇34】 さらにまた処理手段は、パターン形成領域 の周囲に流動体が流出することを防止するためのパンク を形成可能に構成され、当該製造装置は、パターンの形 成後当該バンクを除去する手段をさらに備える。

【0035】 本要明は、所述の流動体により基板上に任 虚のパターンを形成するための基板製造装置であって、 活動体を基板上に出出可能に構成されたインクジェット 式記録へッドと、インクジェット式記録へッドと基板上 との相対位置を変更可能に構成される彫動手段と、イン クマット式記録へッドからの流動体の吐出および駆動 手段による駆動を制御する制御手段と、を備える。そし て制御手段は、既に流動体が吐出されているパターン領域に沿ってインクジェット式記録へッドからさらに同一 の添動体を中出する。

【0036】例えば処理手段は、液滴にエネルギーを供給し、当該流動体の濃度を上昇させることが可能に構成される。

[0037] また処理手段は、液瀬にエネルギーを供給 し、当該液滴の軌道を由げることが可能に構成される。 [0038] さらに処理手段は、液動体に化学反応を生 じさせる物質を、液瀬に供給可能に構成される。

30039] さらにまた処理手段は、統領の属性を検出する可能に構成され、制御手段は、処理手段により検出された液滴の属性に基づいて、インクジェット式記録へッドからの液滴の吐出および邪動手段による駆動を制御する。

[0040]

【発明の実施の形態】以下、本発明を実施するための最 良の形態を、図面を参照して説明する。

[0041] (共通構成)図1に以下の各実施所他で用いる基板製造装置の共通部分の開逸構成図を示す。図1 に示すま方に、本基板製造装置 100は、インクジニット式記録へッド2、処理装置3、駆動機構4および制御回路5を備えている。以下の各実施影響では、処理装置3の配置と処理内容がそれぞれ異なり、残りの構成は各実施形態にほぼ其張して使用される。

【0042】インクジェット式記録ペッドとには、流動 体1のが入れられたインクタンク26がバイブ27を介 して流動体10を供給可能に経験されている。流動体1 0としては、インクジェット式記録ペッドから吐出可能 な流動性を呈するものならば、親水性であると非親水性 であるとを問わずあらゆるものが適用可能である。構成 物全部が液状でなくともよい。例えば導電性を示す金属を微粒子として溶剤中に混入させたものでもよい。

【0043】まずインクジェット式起操ヘッドの構造を 認明する。図18はインクジェット式起操ヘッド2の分 解針視図である。インクジェット式起操ヘッド2は、一 般的なインクジェット式起操ヘッドとして任意の流動体 を吐出可能に構成されていれば十分である。図18のイ ンクジェット式記録ヘッド2では、ノズル211の設け られたノズルプレート21、および影動規23の設けら れた圧力室基板22を、筐体25に嵌め込んで構成され る。正力室基板22は、例えばシリコンをエッチングし て形成され、キャビティ(圧力率)221、側壁222 およびリザーバ223等が形成されている。

【0044】図19にノズルプレート21、圧力室基板 22および振動板23を積層して構成されるインクジェ ット式記録ヘッド2の主要部構造の斜視図一部断面図を 示す。同図に示すように、インクジェット式記録ヘッド 2の主要部は、圧力室基板 2 2をノズルプレート 2 1 と 振動板23で挟み込んだ構造を備える。 ノズルプレート 21は、圧力室基板22と貼り合わせられたときにキャ ビティ221に対応する位置に配置されるように、ノズ ル穴211が形成されている。圧力室基板22には、シ リコン単結晶基板等をエッチングすることにより、各々 が圧力室として機能可能にキャビティ221が複数設け られる。キャビティ221間は側壁222で分離されて いる。各キャビティ221は、供給口224を介して共 通の流路であるリザーバ223に繋がっている。振動板 23は、例えば熱酸化膜等により構成される。振動板2 3上のキャビティ221に相当する位置には、圧電体素 子24が形成されている。また、振動板23にはインク タンクロ231が設けられ、タンク26から任意の流動 体10を供給可能に構成されている。圧電体素子24 は、例えばPZT素子等を上部電極および下部電極(図 示せず)とで挟んだ構造を備える。圧電体素子24は、 制御回路5から供給される制御信号5hに対応して体積 変化を生ずることが可能に構成されている。

【0045】なお上記インクジェット式記録ヘッドは圧 電体素子に体積変化を生じるせて流動体を出出させる構 成であったが、発熱体により流動体に熱を加えその膨張 によって液滴を吐出させるようなヘッド構成であっても よい、

【0046】処理装置3は、基板1に対して所定の処理 を施すことが可能に構成されている。処理装置3は制御 回路5から供給される制御信号Spに対応して処理を行 5、処理装置3の機能、構造に関しては、以下の各実施 形態で明らかにする。

【0047】 駆動機構4は、モータM1、モータM2お よび図示しない機構構造を備えており、インクジェット 記記録ヘッド2および処理装置3をともに、X輪方向 (図1の緒方向)およびY軸方向(図1の現行を方向) に搬送可能に構成されている。モータM1は駆動信号S 対に応じてインクジェット式記録へッド2および処理装 置 3をX輪方向に搬送可能に構成される。モータM2は 駆動信号Syに応じてインクジェット式記録へッド2お よび処理装置をY軸方面に搬送可能に構成される。

【0048】 たお、歴動機構 4 は基核 1 に対するインク ジェット式記録ペッド 2 および処理装置 3 の位置を相対 的に変化可能な構成を備えていれば十分である。このた め上記構成の他に、基板 1 がインクジェット式記録ペッ ド 2 や処理装置 3 に対して動くものであっても、インク ジェット式記録ペッド 2 および処理装置 3 と、基板 1 と がともに動くものであってもよい。また、処理の形態に よっては処理変置 3 がインクジェット式記録ペッド 2 と ともに拠ぎされる必要はなく、処理装置 3 が別値に輸送 されても、静止しているものであってもよい。

【0049】図21を郵限してインクジェット式記録ペッド2の社出原理を示す。同図は図20のA-Aの線における断面限である。流動体10は、タンク26から、振動板23に設けられたインクタンクロ231を介してリザーバ223から供給される。流動体10は、このリザーバ223から供給口224を通して各キャビディ221に流大する。圧電体票子24は、その上低電機と下部電極との側に電圧を加えるとその体積が変化する。この体積変化が振動板23を受那させ、キャビディ21の体積を形化ませる。

【0050】制御信号Shが供給されず、電圧を加えない状態では推動板23の変形がない。制即信号Shが供給され電圧が加えられると、同区の破線で示す位置まで振動板23トや変形後24トの圧電業子が変形する。キャビティ21内の体積が変化すると、キャビティ21内の体積が変化すると、メーズペス1に流された流動体10元円が高まる。ノメルペス1にには流動体12が供給され、後滑11が吐出される。

【0051】 (配置の舷梯) 図2乃至図4を参照して本 発明の基本的な処理の配置をそれぞれ説明する。本発明 はインクジェット式記録へッドから吐出された流動体に 行う処理技需の配置を3つに区別して考える。

【0052】 图2はインクジェット式記録へッドから流 動体を吐出する前に基板に対して処理を行う第1の配置 の概念図である。同図に示すように、インクジェット式 記録ヘッド2および処理装置3は矢印鞭送方向に相対的 に撤送される。第1の配置の場合、処理装置3は進行方 向に対してインクジェット式記録ヘッド2より前に配 から洗動体の被第11が吐出される前に基板1に対 して所定の処理7を行うものである。処理の詳細は以下 の実施形態で影射する。

【0053】図3はインクジェット式記録ヘッドから流 動体を吐出した後に流動体または基板に対して処理を行 う第2の配置の概念配である。同図に示すように、イン グジェット式記録ヘッド2および処理装置3は矢中順送 方向に相対的に撥送される。第2の配置の場合、処理装 盤3は地行方向に対してインクジェット式記録へッド2 より後に配置される。そしてインクジェット式記録へっ ド2から基板1に対し流動体の被演11が吐出された後 に基板1に対して所定の処理12行うものである。処理 の詳細は以下の実施が報で記明する。

【0054】図4はインクジェット式記録〜ッドから吐出された流動体の液滴に直接処理を行う第3の起置の概念図である。第3の配置の場合、処理装置3はインクジェット式記録〜ッド2から吐出された液滴11に対して直接処理可能に配置される。そしてインクジェット式記録〜ッド2から吐出された液動がな液流11に対して動像へッド2から吐出された液動体の液流11に対して所定の処理7を行うものである。処理の詳細は以下の実施形態で説明する

【0055】 (実施形態1) 本発明の実施形態1は化学 的作用 (答解度低下) を流動体に及ぼす処理に関し、主 に上配第1の配置および第2の配置において用いられ ス

【0056】図5に本実施形能1の処理概念を説明する 側面図を示す。本実施形態1の処理装置301は、流動 化11が出出される前の基板1に対して、流動作に混入 している始襲の溶解度を低下させ、その間形分を折出さ せる処理701を適用可能に構成されている。このよう な処理として、熟風の吹き付け、レーザ照射、ランブ隙 射等を行って流動体の溶解成分を薬剤をせるといった処 理が考えられる。同図は第1の配置に適用した構成を示 すが、第2の配置に適用した場合には処理装置301が インクジェット式記録ペッド2の進行方向後方に配置さ れる。

【 0057】熟風の吹き付けを行う場合、処理装置30 1は空気を吹き付けるコンプレッサおよび空気を黙する ヒータ等を備える。レーザ服幹を行う場合には、所定の 被長のレーザ光を照射するレーザ発光用ダイオード、レ ・ザ光を集火するためのレンズ群およびレンズ群を駆動 して適正にレーザ光を基板上に集光するためのアクチュ エータ装置等を備える。ランプ照射を行う場合は、キセ ノンランブ等の高エネルギーを放射可能なランプ、リフ レクタ、レンズ群等を構える。

【0058】前処理を行う第1の配置で上記处理装置 3 01を用いる際、上記処理を流動体の依菌 1 がが生活 れる直前の基板1に対して行う。基板に香弾した被流 は、すでに基板1が熱せられているので、溶弾高度から 溶膜成分が蒸発し、流動体が濃縮される結果として、固 形分が規密あるいは溶解物が附出するようになる。例え ば流動体が溶媒中に全氟の微粒子を含んだものであれ ば、熱の影響・溶媒成分のか落発し、金属微粒子を導 準性のバターンとして基板上に残留させることができ

【0059】後処理を行う第2の配置で上記処理装置3

01を用いる際、既に基板上に吐出された流動体の液滴 に対して上記処理を行う。同様の作用により溶解物を析 出させることができる。

【0060】 たお、上窓処里の他に、局所的に減圧させたり雰囲気を変更可能に構成してもよい。このように構成してもよい。このように構成してもよい。このように構成すれば、旋動体に対する溶解物の溶解度を低下させ、結果として溶解物を折出させることが可能となる。また基板全体と数する等の信望も水実施形態の一変形例に加えられる。このためには基板1の載度台にヒータ装置等を設けることになる。

[0061]上記のように木実施形態1によれば、エネルギーを加えることにより流動かから固形物質を疫留あいば折出をせることができ、パターン形成が容易に行える。また処理装置によって同所的に加熱するのみで済むので、加熱設備が小さくて済み、消費エネルギーを低く抑えることができる。

【0062】(実施形態2)本発明の実施形態3は化学 的作用(化学反応)を流動体に及ぼす処理に関し、主に 上記第1の配置および第2の配置において用いられる。

【0063】図6に本実施形能2の処理概念を説明する 側面図を示す。本実施形能2の処理装置302は、流動 作11が出出される前の基版1に対して、遊動体に対し 化学反応や分散系の破壊をもたらす反応被702を吐出 可能に構成されている。処理整置302としてはインク ジェット次記録へッド2と同様な構成を用いることが好 ましい、遊動体の液満11とほぼ同量の反定液を削縛し ながら吐出させることができるからである。同図は第1 の配置に適用した場合の構成を示すが、第20配置に適 用した場合には処理装置302がインクジェット式記録 ペッド20連行方向後方に配置される。

【0064】分散系の破壊をもたらす处理として、減動 体の液満11がスチレンーアクリル樹脂により分散した 有機顔料を主成分とする場合に、反応液702として硝 酸マグネンウム木溶液を吐出する場合が挙げられる。ま た化学反応をもたらす処理として、流動体の液満11が エボキン樹脂を主成分とする場合に、反応液702とし てアミン類を社出する場合が挙げられる。

【0065】前処理を行う第1の配置で上記処理装置302を用いる際、挑動体の検適11が吐出される前のパケーン形成前域に対して上記反応被702を吐出する。反応被702が吐出されたパケーン形成領域上に被適11が着弾すると、分散系の破壊あるいは化学反応が生じ、固形物質13が指出する。例えば液菌11が金属な含含む場合、この塩と反応可能な反応被702を用いることにより、導電性のある金属パケーンを形成できる。【0066】後処理を行う第2の配置で上記处理装置3を用いる際、既に基度上に吐出された流動体の液資11に対して反応液702を吐出する。同様の作用により固形物質13を生成させることができる。

【0067】なお上記実施形態ではインクジェット式記

録ヘッドを2個使用したが、さらに複雑な反応を生じさせるためには、他の反応液を吐出可能なヘッドを増やしていけばよい。

[0068]上記したように実施形態2によれば、反応 液により分散素の破壊や化学反応を生じさせるので、イ ングジェット式起除ヘッドを微数実備するだけでパター ンを形成できる。特に同様な構成のヘッドを複数設け、 そこから吐出させる物質の分を変えればよいので、製造 実體の費計が実易である。

【0069】 (実施形態3) 本発明の実施形態3 は物理 化学的作用として基板の線和性を改善する処理に関し、 主に上記第1の配置において用いられる。

【0070】図7に本実施形態3の処理概念を説明する 平面図を示す。本実施形態4の処理装置303は、流動 体11が吐出される前の基板1のパターン形成領域を、 流動体に対し緩和性を備えるように表面改質可能に構成 されている。

【0071】 緩和性を備えるように表面改質する処理としては、流動体が極性分子を含む場合(水分を含む場合)は、シランカップリング制を塗布する方法、酸化アルミニウムやシリカ等の多孔俣膜を形成する方法、砂ルゴン等で逆メバッタをかける方法、コーナ放電処理、ブメで処理、大才必処理、股船処理等、公知の種々の方法を適用する。流動体が極性分子を含まない場合には、バラフィン等を塗布する方法、ガスブラズや処理、カップリングの建築等がある。

【0072】シランカップリング剤を用いる場合には、処理装置303は、無機質と反応しやすいアルコキシ基ペハロゲンなどの加水分解性の環境基と有機質と反応しやすいアルコキシ基をサいビール基、エボキン派、アミノ基等とをともに持つ有機がイ素化合物(シランカップリング制)を塗布可能に構成される。塗布方法としては、インクジェット式配金のドからの材料社用セポールペン類の企布機構による直接塗布が考えられる。多孔質膜を形成する場合には、処理接置303は多孔質材料、例えばよ1,0。やリカを整体可能に構成される。塗布方法はEと同様である。遮スバッタをかける方法の場合には、処理装置303としてスパックリン学基度を適用する。すなわち、カンドド、基板をアノードにする電板、アルン雰囲気調整接情および電源等を備える。逆スバック処理により、基板の表面が活性化され、現水性の貿条集に置き後、

調整機構および電脳等を備える。 遊スパック処理により、基板の表面が低性化され、現水性の置換基に置き換わり、基板表面が改質される。 思った放電を行う場合には処理装置303として高電圧放電用電極を備え、基板1に接地電圧を印加可能に構成する。 基板表面に高電圧が局所的に印加さるとにより基板の有機分子の一部が親水性のある基に置き換り表面改質される。 プラズマ処理をするには、処理装置303として気体放電で生じたプラズマを噴出可能に構成する。 家外線 保照針する場合には、処理装置303として紫外線限射用ランプを備える。オンン処理を行う場合は、処理装置303とし

てオゾンの流通する雰囲気下で所定の電圧を印加し、活性化したオゾンを基板に放出可能に構成する。限點処理 を行う場合には、処理装置303として、基板上に過マンガン酸、クロム酸、硫酸、硝酸等の強アルカリを供給可能に構成する。パラフィン等を塗布する場合には、処理装置303にボールペン類似の塗布機構を使用し、パターン形成領域の両辺を中心とする領域に溶解したパラフィン等を塗布する。

【0073】上記処理装置303を備えたので、シラン カップリング剤を塗布した場合には、パターン形成領域 703に塗布されたシランカップリング剤が基板材料と 密着し、一方で水に対して濡れ易い基が表面に露出す る。多孔質膜を形成した場合には、パターン形成領域7 03に形成された酸化アルミやシリカ等の膜が多孔質で あるため流動体を含み易くなる。逆スパッタを行った場 合にはパターン形成領域の表面温度が上昇し膜の付着力 を向上させたり親水性膜に変えたりできる。コロナ放電 を行った場合には、基板表面にOH基やCOOH基が生 成するため親水性を備えるようになる。プラズマ処理を 行った場合、基板表面の高分子の未反応基と架橋層を生 ずる。未反応基は容易に酸化され、OH基やC=O基、 CHO基、COOH基等が発生し親水性を備えるように なる。ポリエステルやポリプロピレンを使用した基板等 に整外線照射を行った場合。OH基やCOOH基を生成 して親水性を備える。ABSやポリプロピレン等にオゾ ン処理を行った場合には、表面の親和性が改善される。 脱脂処理を行った場合には、基板表面が酸化され親水性 の基に置換され親水性を示すようになる。パラフィン等 の途布処理を行った場合には、途布された領域が非極性

【0074】上記実施形態3によれば、インクジェット 式記録ペッド2か6の流動体の吐出に先行して表面改質 されたパターン形成領域703に銀和性を示す腰が形成 されるので、パターン形成領域に着弾した被震12が広 がり過ぎたり分離したりするおそれが少なくなる。

分子に対し親和性を示すようになるため、流動体が非極

性分子である場合に濡れ易くなる。

【0075】(実施形態4)本発明の実施形態4は物理 化学的作用としてバターンの両側に非規和性領域を設け る処理に関し、主に上記第1の配置において用いられ を

【0076】図8に本実施形態4の処理概念を説明する 平面図を示す。本実施形態4の処理装置304は、基板 1のパターン形成射板外側の領域に流動体に対し非親和 性を示す膜704を形成可能に構成されている。

[0077] 非規和性を示す販を形成する処理として は、流動体が極性分子を含む場合には上記したパラフィ ン等を憧縮する方法等が挙げられる。流動体が極性分子 を含まない場合には、上記実施形態3で提明したシラン カップシング剤を塗布する方法、酸化アルミニウムやシ リカ等の多元質機を形成する方法、アルビン等で迎スパ ッタをかける方法、コロナ放電処理、プラズマ処理、紫 外線照射処理、オゾン処理、脱脂処理等、公知の種々の 方法を適用する。

【0078】非極性分子に対し非親和性を示す談や、極 性分子に対し親和性を示す談の形成方法については上記 家施形儀3と同様なので説明を省略する。

【0079】上記したように実施形態4によれば、イン クジェット式記録へッド2からの流動体の出出に先行し てパターン形成領域の両限に活動体に対しま規則性を示 す膜704が形成されるので、パターン形成領域からは み出た流動体に非規料性膜704ではつかれるため、流 動体なケパターン構成領域に収めることができる。

【0080】(実施形態5)本発明の実施形態5)は物理 化学的作用としてバターン形成領域を、流動体を吸収可 能に形成に形成する処理に関し、主に上紀第1の配置に おいて用いられる。

【0081】図9に本実施形態5の処理概念を説明する 側面図を示す。本実施形態5の処理装置305は、基板 1のパターン形成領域に流動体を吸収する吸収層705 を形成可能に構成されている。

【0082】吸収層705としては、ボリビニルアルコ ール (PVA) ポリ酢酸ビニル等を適用することが可 能である。ボリビニルアルコールの塗布するために、処 理装置305はボールベン類似の塗布機構を備えること が考えられる。

【0083】上記構成において、処理装置305が流動 体の世出出先行して吸収層705を形成し、形成された 吸収層705の上にインクジェット式記録か、ド2から 流動体の液滴11が世出される。吐出された流動体の液 滴11のうち一部は吸収層705に吸収されて層14内 に流動体が定着する。このため吸収されて層14内 メターンが形成されることしな収層を形成した領域に パターンが形成されることしな収層を形成した領域に

【0084】本実施形態5によれば、インクジェット式 記録へッド2からの流動体の吐出に先行して処理装置3 05が吸収層を形成するので、吸収層の通りにパケーン 形成が行え、過剰な流動体を吸収層に吸収させることが できる。

【0085】 (実施形態6) 本巻明の実施形態6は物理 化学的作用としてバターン形成領域の境界付近に震動体 の適出を抑えるパンク (土手状のもの)を形成する処理 に関し、主に上記第1の配置において用いられる。

【0086】図10に本実施形態6の処理概念を説明する平面図を示す。本実施形態6の処理装置306は、基板1のパターン形成領域の境界付近に流動体の流出を防止するパンク706を複数形成可能に構成されている。 処理装置306としては、パンクの材料を一定の高さで 形成するを歌があるため、ボールペン類似の愈布機構を 複数別いる。各絵布機構はパターン形成領域の幅が向は その幅だけ離れて配置される。パンク706の材料としては、ポリイミド、アクリル樹脂、エポキン樹脂等が考 えられる.

【0087】上記構成において処理議産306は流動体 の吐出に発行してバンク706を形成していく。バンク の形成後にバターン形成酸酸に流動体の成資11が吐出 されるとバンク706が存在するためにバンク外に流動 体が流出していくことはない。流動体は二つのバンクに 囲まれたパターン形成磁磁が下弧化する

【0088】なお、流動体が固化した後にパンク706 を取り除く工程を設けることは好ましい。流動体がパタ ーンとして定着すればパンクは不要になるからである。 パンクの除去にはプラズマアッシング、エッチング等の 方法を用いる。

【0089】本実施形態もによれば、インクジェット式 記録ペッドからの流動体の吐出に先行してバンクを形成 するので、流動体がバターン形成領域外に流出すること を防止できる。バターンの定着後にバンクを取り除け ば、バターンの編を飲く維持できる。

【0090】(実施形態7)本発明の実施形態7は物理 的作用として吐出された流動体を整形する処理に関し、 主に上記第2の配置において用いられる。

【0091】図11年前医、(b) は側面図を示す。 (a) は平面医、(b) は側面図を示す。 本実施形態アの処理装置310は、基板1に需導した流動体12をパターン形成領域の境界に沿って擦る針状部材710を複数倒えている。 含針状部材710はパターン形成領域の個名向にその幅だけ離れて配置される。 対象が 材710としては、一定の機能的強度がある一方、基板に損傷を与えない程度の弾性があることが好ましい。このため針状部材710は樹脂、ゴム、柔らかい金属等の材料で構成さ

【0092】上記構成においてインクジェット式記録へ ッド2が流動体を基板に仕出するとわずかながら吐出方 向の顔差を含みながらパターン形成領域上上着弾する。 そのため着準低量はほぼパターン形成領域上を推介する。 そのため音を低量はほぼパターン形成領域からはみ出す 部分がある、処理装置310は、このようにはみ出した 流動体12をパターン形成領域の境界に沿って振ってい くので、はみ出した部分がパターン形成領域内に戻さ れ、一定の値のパターン15が形成される。

【0093】 本実施形態 7 によれば、インクジェット式 記録ヘッド 2 から吐出された流動体の液滴の着弾位置が ずれていても、その後に処理装置 3 1 0 がパターンを整 形していくので、整ったパターンが形成できる。

【0094】 (実施形態 8) 未乗明の実施形態とは物理 的作用として着弾された流動体のうち過剰分を吸収する 処理に関し、主に上記第2の配限において用いられる。 【0095】 図12に本実施形態8の処理概念の説明図 である。(a) は平面図、(b) は側面図を示す。本実 配形態8の処理被置311は、パターン形成領域に沿っ で移動し基板1に着弾した流動体12の過剰分を吸収可 能に構成された吸収部材711を備えている。吸収部材 711としては、過剰な流動体を吸収可能なパイプ形状 をしていることが好ましい。この吸い取った流動体を再 びインタジェット式配肄へッド2から吐出可能に構成し てもよい。吸収部材711は、一定の機械的強度がある 一方、暴坂に損傷を与えない程度の弾性があることが好 ましい。このため針状部材は樹脂、ゴム、柔らかい金属 等の材料で構成する。

【0096】インクジェット式記録ヘッド2からは若干 過剰に適齢体を牡田した方がパターンの分析が生じにく い。しかし過剰な流動体の液滴が音弾すると必要なパタ ーン形成原線外に広がる。未実施形態では洗砂体の液滴 が基板に着弾された直後に処理装置311の吸収部材7 11が過剰次流動体を吸収していくことになる。このた めパターン形成解域以外に流動体が広がることがない。 また吸収した流動体を再びパイクジェット示記録ヘッド 2に供給すれば流動体材料を節減することができる。

【0097】(実施形態9) 本発明の実施形態9は物理 的作用として時間差で流動体を吐出する処理に関し、主 に上記第1の配置および第2の配置において用いられ 2

【0098】図13に本実施形態9の処理販金を設明する側面図を示す。本実施形態9は、処理装置としても流動体を吐出可能に構成されたインクジェット元配録へッド2を備えている。すなわち同一の流動体を吐出するインクジェット式記録へッド2が所定の距離をおいて配置され、相前後して同一のパクーン形成領域に流動体を吐出可能に構成されている。

【0099】上記構成において先行するインクジェット 式記録ヘッド2aは、若干の関隔をおいて流動体の着弾 跡12aがパターン形成領域上に配置されるように液流 11aを叶出する、後続するインクジェット式記録へッ ド2bでは、既に着弾している流動体12aと合わせて パターン形成領域が流動体で満たされる程度の量に調整 して流動体の液滴12トを吐出する。先に着弾した流動 体12aには表面張力が作用しており、後から着弾する 流動体12トにも表面張力が作用する。表面張力が作用 している液滴上に他の液滴が落ちると、表面張力故に瞬 時に二つの液滴が混ざらず、後から落ちた液滴は先に着 弾した液滴上を滑ってその周辺に落ちる。 したがって本 宇宙形態では先に所定の間隔をおいて洗動体12aが着 弾しているため、後から吐出された流動体の液滴11b は、先に着弾した流動体12aの存在しない領域に着弾 する。このためパターン形成領域には隙間なく流動体が 着弾し、その密度も一定になる。

【0100】なお、上記形態は、イングジェット式記録 ヘッド2を一個の存設け、同一のパターン形成領域を往 復可能に制練回路6を構成してもよい。時間差で流動体 が吐出される点で同一の効果が得られるからである。こ の場合、ヘッドの個数を削減できるという効果を奏す Χ.

【0101】本実施形態9によれば、時間差で同一の流 動体を吐出するので、基板に着弾する流動体の密度を均 一することができ、均一な厚みのバターンを形成でき る。

【0102】 (実施形能10) 本発明の実施形能10は 化学的作用としてレーザ照相により液溶の濃度を上げる 处理に関し、主に上記第3の配置において用いられる。 【0103】図14に本実施形態10の処理概念を説明 する側面図を示す。本実施形態10の処理概念を説明 する側面図を示す。本実施形態10の処理概念を説明 する側面図を示す。本実施形態10において処理装置3 20は第3の配置を接り、インクジェフト末記録へ にレーザ光720を照射可能に構成されている。すなわ も処理装置320はレーザ光を照射するために図示しな いレーザ発光用ダイオード、レンズおよびアクチュエー タを備える、レーザ発光用ダイオードはエネルギー源と して所定の短波長のレーザ光を発光し、レンズはこのレ ーザ光を被薄に広集光可能に構成されている。アクチュエー りは液滴11に正しくレーザ光720が焦点を観がよう にレンズおよびレーザ発光用ダイオードのに電響がよう にレンズおよびレーザ発光用ダイオードの信置補正を行

【0104】なお、瞬時にエネルギーを与える手段としてはレーザ光の照射が好ましいが、エネルギーを被額に 供給可能であればこれに限定されるものではなく、熱風 供給、ランブ照射、雰囲気過低等が種々の構成を適用で きる。

うことが可能に構成されている。

【0105】上記構成においてインクジェット式記録へッド2から流動体の液質 11 が吐出されると、所定位置で処理装置 20 から射出されたレーザ光7 20 が液液 11 上で焦点を結ぶ。これにより液滴11 には高いエネルギーが明寺に与えられる。エネルギーが与えられた現 第11 は温度が上昇するため流動体に溶解している物質の濃度が上がったり、含着されている固形やの成膜化が促進されたりする。そして着弾するまでに不要な溶粧板 上に着弾する。したがつてイングェットは記録へットから吐出させるのに要求される流動体の粘度がパターン形成に適当な流動体の地度がパターン形成に適当な流動体の地度がパターン形成に適当な流動体の地度がパターン形成に適当な流動体の機度に緩縮することができる。【0106】本実施形態10によれば、インクジェット

れているのでない。 大記録ヘッド2から吐出された液滴11が着弾するまで で不要な溶媒成分を除まできるので、基板に着弾する流 動体が過剰に広がるのを防止でき、またパターン形成ま での時間を短くできる。

【0107】 (実施形態11) 本発明の実施形態11は 物理的作用として流動体の液滴に他の液滴を衝突させて 軌道を曲げる処理に関し、主に上記第3の配置において 用いられる。

【0108】図15に本実施形態11の処理概念を説明 する側面図を示す。本実施形態11において処理装置3 21 は第3の配置を採り、バターン形成領域の延在方向 に垂直な方向であって、インクジェット式記録ヘッド2 を中心として対向するように配置される。各処理装置3 2 1 は異なる方向から液滴にエネルギーを供給可能に印 加できる構成を備える。エネルギーとして所定の液滴を 衝突させるという力学的エネルギーを加える場合には、 所定の液滴を吐出可能な構成、例えばインクジェット式 記録ヘッド2と同様な構成を備える。所定の液滴とは後 述する化学反応を目的とする場合はその反応を起こさせ る反応被、反応を起こさせたくない場合にはインクジェ ット式記録ヘッド2が吐出するものと同一の流動体を吐 出させる。エネルギーとして空気を用いる場合には、空 気を吹き付けるためのコンプレッサおよびノズル等を備 える。エネルギーとして電界を用いる場合には、流動体 の液滴11の軌道を挟んで両側に電極を設け、両電極関 に置圧を印加する電源を備える。電界を用いる場合、イ ンクジェット式記録ヘッド2から吐出される流動体の液 滴11を正または負に帯電させる構成も設ける。

【0109】上記構成においてインクジェット式記録へ ッド2から流動体の液滴11が吐出されると、制御回路 5は処理装置321に制御信号Spを供給して、予め指 定されたパターン領域に流動体が着弾するよう制御す A. 処理装置321が所定の液滴を吐出する場合には、 インクジェット式記録ヘッド2からの液滴11の吐出に 同期して処理装置321から液滴が吐出され、基板に着 弾する前に両者が衝突し、液滴の着弾位置が変更され る。処理装置321が空気を噴出する場合にはインクジ エット式記録ヘッド2からの液滴の吐出に同期して空気 が吹き出され、流動体の液滴の軌道が曲げられる。処理 装置321が電界を印加する場合には、まずインクジェ ット式記録ヘッド2からの液滴11を帯電させ、両電極 間における電界の向きおよびその大きさを制御信号Sp によって調整すれば、陽極方向または陰極方向のいずれ かの方向に任意の変位だけ液滴の着弾位置を変更させる ことができる。

【0110】上記構成によれば、任意のバターン幅でパターン形成が行える。例えば図15に示すように、パターン形成が行える。例えば図15に示すように、パターン幅が息も狭い領域A1では制御信号5pの供給を発生した。 も細いパターンが描ける。一方パターン幅を広くする領域A2では複数の処理装置。21に制御信号5pの企工機能がのである。例前信号5pが保格されると制御信号5pを記して、一点に供給する。例如信号5pが促進が変動する。例えば朝御回路321に結構的信号を加えるとエネルギー721aが供給された個優月に着弾する。制御回路321には簡単6を加えるとエネルギー721aが供給された個優月とに着弾する。インクジェット式記録ヘッド2に供給する制御信号5kに同限させて制御信号5pを制御回路321に生出され、液変11止出出されることに発揮を優別を使用され、液変11止出出されることに発揮を開かる。その結果として着弾した 場合の直径よりも広い幅のパターン形成領域に流動体を 充填させることができる。

【0111】本実施形態11によれば、制御回路321 が出力するエネルギーを制御することで任意のパターン 幅でパターンを形成することができる。

[0112] (実施形態12) 本発明の実施形態12は 物理化学的作用として流動体の液滴に反応波の液滴を衝 突させて化学反応を促進する処理に関し、主に上記第3 の配置において用いられる。

【0 1 1 3] 図16に本実施所能12の処理転念を設明する側面図を示す。本実施所能12において処理家置32は第3の配置を採り、インクジェット式解外ッド2から射出された被蔣に空中で反応液722を混合可能に構成される。処理装置32と1反応液を制御可能に吐力するために、例えばイングジェット式配験ペッド2からの役職1の興造となるがく残り場合になるように襲きされる。角度が改いほど、両被流が接触可能となる期間が長くなるからである。制御回路5はインクジェント式配録ペッド2に後れずるが表別が長くなるからである。制御回路5はインクジェント式配録ペッド2に後れずる制御信号等がに関始させて処理装置32とに制御信号5pを供給可能に構成される。

【0114】上記構成においてインクジェット式記録へ ッド2から流動体の波滴11が吐出されると、ほぼ同時 に反応被722が処理装置320から吐出される。両者 は基板1に到達する前に接触し化学反応等を生じ、反応 中または反応後に基板1に着弾する。

【0115】本実施形態12によれば、空中に反応を生 じさせることができるので、社団時には反応していては 困るが着爆時には反応していることが重望ましい場合に適 する。例えば反応すると固化が始まったり新食性が発生 したりする場合に適用できる。

【0116】(実施形態13)本発明の実施形態13は 流動体の液滴の検出と補正処理に関し、主に上記第3の 配置において用いられる。

【0117】図17に本実施施13のプロック図を示。同図は図1とほぼ同等の構成を備えるが、処理装置330およびその検出手段331を備える点で異なる。処理装置10分に、新御信号ら1に応じてレーザ光等値進性のよい光をインクジェット式記録へッド2から吐出された液質110列道を視りって射出可能に構成され、例えばレーザ条光用ダイオード、レンズおよびアクチューク等を備えている。検出手段331は、処理装置30から射出された光を検迫可能に構成され、例えばストデラクタで構成される。横側手段331からの検出信号を入力し、液流11の吐出タイング、位置、方向、速度、大きき等を検出可能に構成される。そしてインクジェット式記録へッド20秒用による。そしてインクジェット式記録へッド20秒用による。例えば、9出場では、110分に表情なされる。例えば、9出場では、110分に表情なされる。例えば、9出場では、110分に表情なされる。例えば、9出場のインが基準よりすれている場合

にはそのずれを補償するようにインクジェット式配録へ ッド2の流動体吐出を制御する制御信号Shのタイミン グを補正する。位置や方向がずれている場合には液滴の **著單位置がずれてしまうので、このずれを補償するよう** にエータM1に対する駆動信号SxまたはモータM2に 対する駆動信号Syを供給する。これにより基板1に対 するインクジェット式記録ヘッド2の相対位置が補正さ 液動体をパターン形成領域に沿って適正な位置に着 弾させることができる。液滴の速度の検出は、検出信号 Sn2中のパルスの幅に応じて計算する。すなわちフォト デテクタの検出面積が決まっているので、液滴の通過に よるパルスの幅が小さければ速度が早く、パルスの幅が 大きければ速度が遅いと考えられる。これらは線形的に 対応する。液滴の速度が基準よりずれた場合、基準時よ り早くまたは遅く液滴が基板に着弾することになる。こ のずれを補償するために、制御回路5はY軸方向の相対 位置を調整すべくモータM2に制御信号Svを供給す る。的的の大きさの検出は、検出信号 Sp2のパルスの振 幅から検出する。液滴の径が大きければ光を遮る面積が 大きいので、検出信号中のレベル変動も大きくなるから である。液滴の大きさが許容値よりもずれた場合、適正 な着弾が担保できなくなるので、制御回路5はヘッドの クリーニングをしたり警報を出力したりする措置をす る。

記録ヘッドからの液滴の準道を検出して相正するので、 ヘッドを長時間使用して特性変化が生じた場合やヘッド に縮がある場合でも正確なパターン形成が可能である。 【0119】(その他の変形例)本発明は上記実施形態 によらず権々に変形して適用することが可能である。す なわちインクジェット式配線ヘッドから流動体を吐出す る他に、その吐出前やその牡出後に、または基板に液滴 が着弾する前に処理を行うものであれば、本発明の思想 の範囲に入る。例えば上記各実施形態ではパターン形成 を目的としていたが、これに拘るものではない。工業的 用途であると民生的用途であるとを問わず、インの多エット式記録ヘッド等からインクを出して特定の効果を 得るものであれば縁をに適用することが可能である。

【0118】本実施形態13によればインクジェット式

【0120】また、上記各実施形能は独立に適用しても 複数を同時に適用してもよい。特にバターン形成が複数 工程によって完了する場合には、複数の処理装置により 処理することは好ましい。何えば、液滴吐出紙に表面改 寛宅第1の配置の処理装置により行って液滴を基板に差 着し易くし、世出された流極や放着の磁排を検出しそ の位置補正を行う処理を第3の配置の処理装置で行い、 最後に基板上の液滴の濃縮を第2の配置の処理装置で行い。 等が考えられる。

[0121]

【発明の効果】本発明によれば、基板上に流動体が吐出 される前に処理可能に構成したので、インクジェット方 式を利用したバターン形成を前処理により促進可能である。したがって、大がかりな工場設備を利用することなく、安価に基板に任意のバターンを形成することができ

【0122】本発明によれば、基板上に流動体が吐出された後に処理可能に構成したので、インクジェット方式を利用してパターン形成を後処理により促進可能である。したがって、大がかりな工場設備を利用することなく、安価に基板に任養のパターンを形成することができる。

【0123】本発明によれば、漆動体が吐出された瞬間 に処理可能に構成したので、空中で被滴を反応させたり エネルギーを加えたりできる。したがって、大がかりな 工場設備を利用することなく、安価に基板に任意のパタ

ーンを形成することができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態における基板製造装置の構成 図である。

【図2】第1の配置(前処理)の説明図である。

【図3】第2の配置(後処理)の説明図である。

【図4】第3の配置(吐出直後処理)の説明図である。

【図5】実施形態1の処理概念を示す側面図である。

【図6】 実施形態 2 の処理概念を示す側面図である。

【図7】実施形態3の処理概念を示す平面図である。

【図8】実施形態4の処理概念を示す平面図である。

【図9】実施形態5の処理概念を示す側面図である。

【図10】実施形態6の処理概念を示す平面図である。

【図11】実施形態7の処理概念を示す図であり、

(a) は平面図、(b) は側面図である。

【図12】実施形態8の処理概念を示す図であり、

(a) は平面図、(b) は側面図である。

【図13】実施形態9の処理概念を示す側面図である。 【図14】実施形態10の処理概念を示す側面図であ

【図15】実施形態11の処理概念を示す平面図であ

【図16】実施形態12の処理概念を示す平面図であ

【図17】実施形態13の処理概念図である。

【図18】インクジェット式記録ヘッドの分解斜視図で

【図19】インクジェット式記録ヘッドの主要部の斜視 図一部断而図である。

【図20】インクジェット式記録ヘッドの吐出原理説明 図である。

【符号の説明】

1 …基板

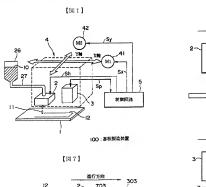
2…インクジェット式記録ヘッド

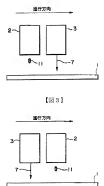
3、301~330…処理装置

4…駆動手段

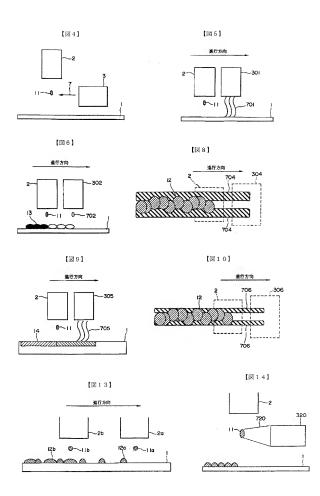
5…制御回路

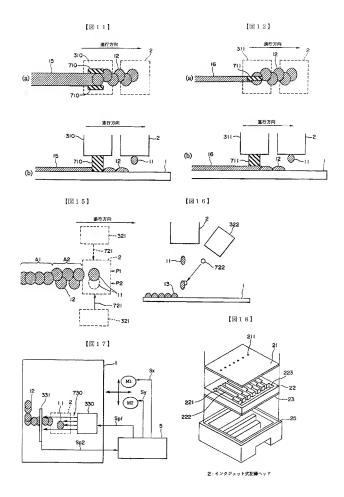
7、701~730…処理の内容

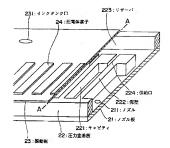




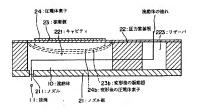
[Z 2]







[図20]



フロントページの続き

(72)発明者 根橋 聡 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式会社内